
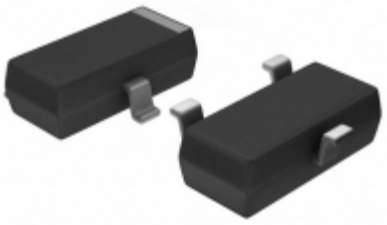







	<h2>SI2305DS-T1-E3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI2305DS-T1-E3</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 8V 3.5A SOT23-3</p> <hr/> <p>Datenblätter:  SI2305DS-T1-E3.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, 565445 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI2305DS-T1-E3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET P-CH 8V 3.5A SOT23-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	565445 pcs Stock
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
Supplier Device-Gehäuse	SOT-23-3 (TO-236)
Verlustleistung (max)	1.25W (Ta)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	8V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	3.5A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	52 mOhm @ 3.5A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	800mV @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	15nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1245pF @ 4V
Verpackung	Original-Reel®








SI2305DS-T1-E3 ist neu im Original, Suche SI2305DS-T1-E3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI2305DS-T1-E3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI2305DS-T1-E3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI2305DS-T1-E3 Electro-Films (EF1) / Vishay MOSFET P-CH 8V 3.5A SOT23-3</p>	 <p>SI2305DS-T1 VISHAY SI2305DS-T1 VISHAY</p>	 <p>SI2305DS-T1-E3 VISHAY VISHAY SOT-23</p>	 <p>SI2305DS-T1-GE3 V SI2305DS-T1-GE3 V</p>
 <p>SI2306 VISHAY SI2306 VISHAY</p>	 <p>SI2305DS A5SHB VISHAY VISHAY SOT-23</p>	 <p>SI2305WCB TOSD SI2305WCB TOSD</p>	 <p>SI2305DS-E3-T1 VISHAY VISHAY SOT-23</p>

heiße Teile

Mehr

 SI2304BDS-T1-E3	 SI2304BDS-T1-GE3	 SI2304BDS-T1-GE3	 SI2304BDS-T1-E3	 SI2304DDS-T1-E3
 SI2304DDS-T1-GE3	 SI2304DDS-T1-GE3	 SI2304DS	 SI2304DS-T1	 SI2304DS-T1-E3
 SI2304DS-T1-GE3	 SI2305-CDS-T1-GE3	 SI2305ADS-T1-E3	 SI2305ADS-T1-E3	 SI2305ADS-T1-GE3
 SI2305ADS-T1-GE3	 SI2305BDS-T1-E3	 SI2305BDS-T1-GE3	 SI2305CDS-T1-E3	 SI2305CDS-T1-GE3
 SI2305CDS-T1-GE3	 SI2305DS	 SI2305DS-E3	 SI2305DS-T1	 SI2305DS-T1-E3
 SI2305DS-T1-GE3	 SI2305WCB	 SI2306BDS	 SI2306BDS-T1	 SI2306BDS-T1-E3
 SI2306BDS-T1-E3	 SI2306BDS-T1-GE3	 SI2306BDS-T1-GE3	 SI2306CDS-T1-E3	 SI2306DS
 SI2306DS-T1	 SI2306DS-T1-E3	 SI2306DS-T1-GE3	 SI2306WCA	 SI2307BDS
 SI2307BDS-T1-E3	 SI2307BDS-T1-E3	 SI2307BDS-T1-GE3	 SI2307BDS-T1-GE3	 SI2307CDS
 SI2307CDS-T1-E3	 SI2307CDS-T1-E3	 SI2307CDS-T1-GE3	 SI2307CDS-T1-GE3	 SI2307DS

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited